



CVD法による複層グラフェンの合成と評価

グラフェンミニ講演会・見学会

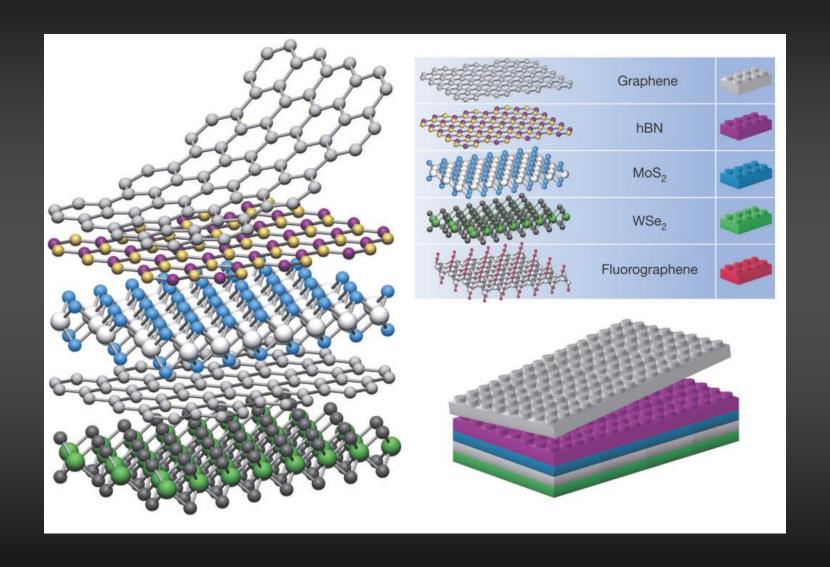
名古屋大学 東山キャンパス 2014年2月19日

北浦 良



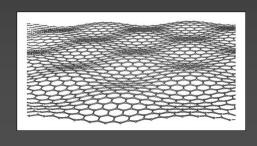
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻

積層型原子層へテロ構造(複層グラフェン)

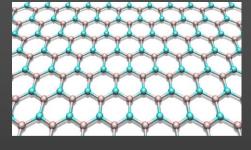


コンテンツ

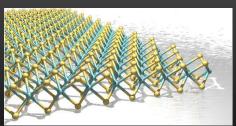
原子層物質の CVD法による合成 および 評価法 の紹介



1. グラフェン



2. 六方晶窒化ホウ素 (hBN)



3. 遷移元素ジカルコゲニド (TMDC)

グラフェン Graphene

グラフェンCVD成長装置

CVD装置の外観

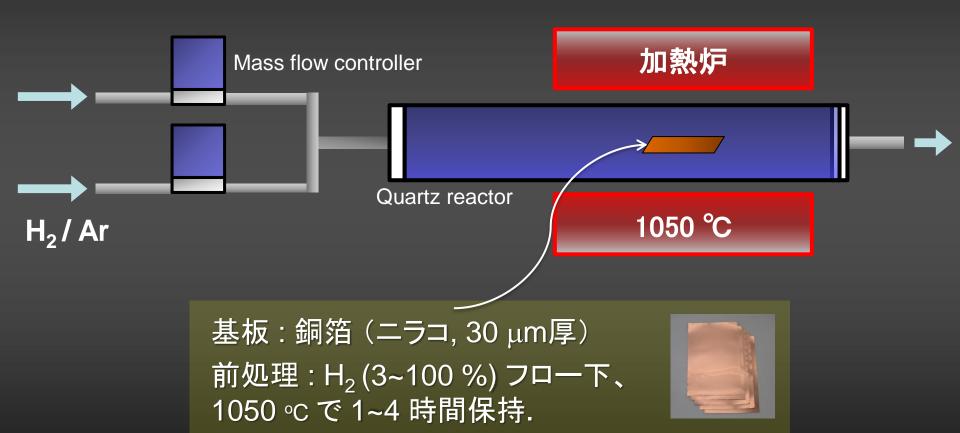




2号機 1号機

グラフェンのCVD合成

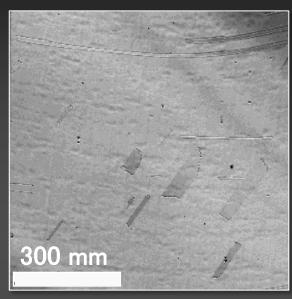
CH₄ / H₂ / Ar (CH₄ 濃度 0.01 %)



R. Ruoff et. al., Science, 324, 1312, 2009

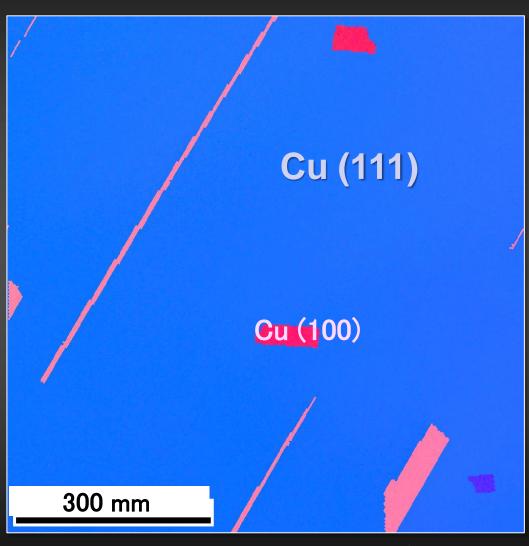
R. Ruoff et. al., JACS, 133, 2816, 2011

前処理後のCuの結晶方位



処理後のCu箔のSEM像



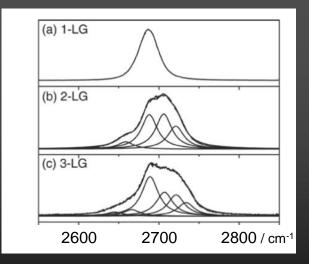


処理後のCu箔のEBSDマッピング像

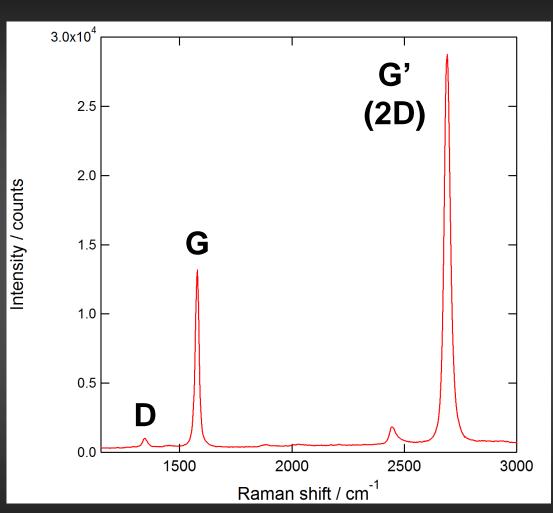
グラフェンの構造評価:ラマン分光



ラマン分光装置 (LabRAM HR-800)

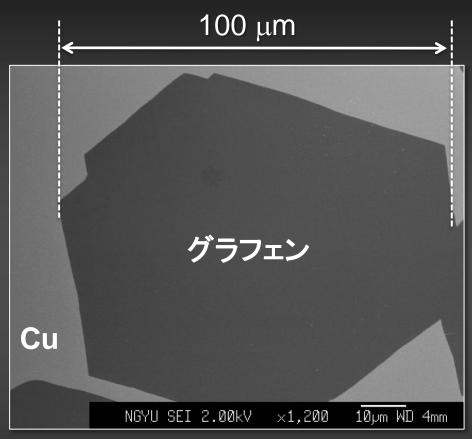


Nano Lett., 751-758 (2010)

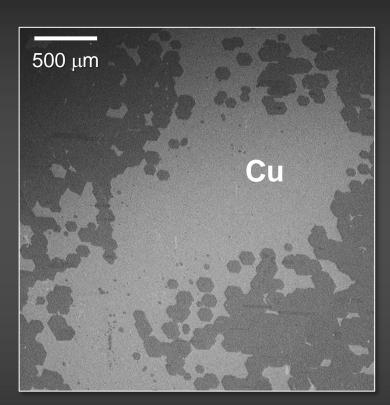


典型的なグラフェン(CH4, Cu箔)のラマンスペクトル

グラフェンの構造評価:SEM観察



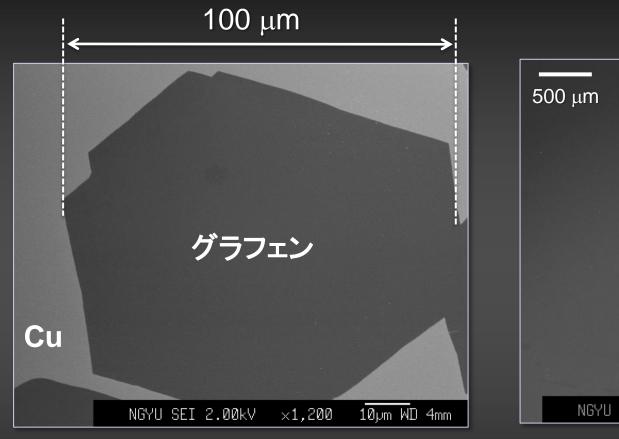
グラフェン(Cu箔、CH4)のSEM像



低倍率のSEM像

~ 300 µm サイズのグラフェン(核密度小)

グラフェンの構造評価:SEM観察



グラフェン(Cu箔、CH4)のSEM像

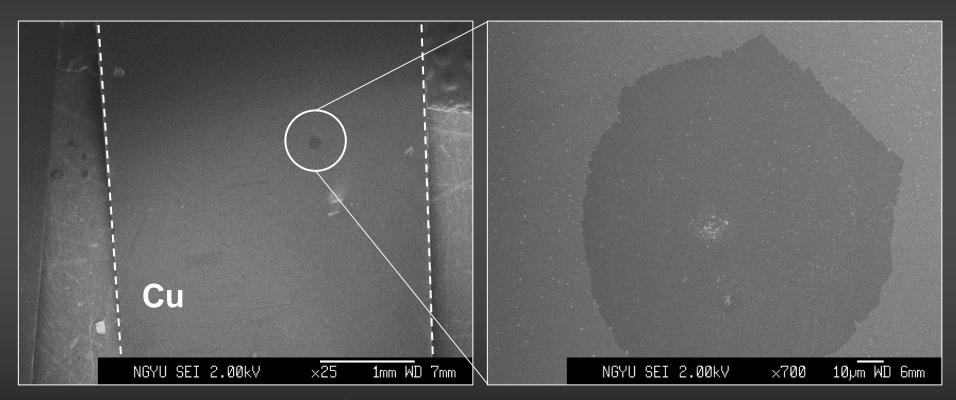


低倍率のSEM像

~ 300 µm サイズのグラフェン(核密度小)

酸化処理の効果:結晶核密度の減少

Cu箔の酸化処理 (酸素濃度 5 x 10³ ppm, 3 min, 1050 °C)



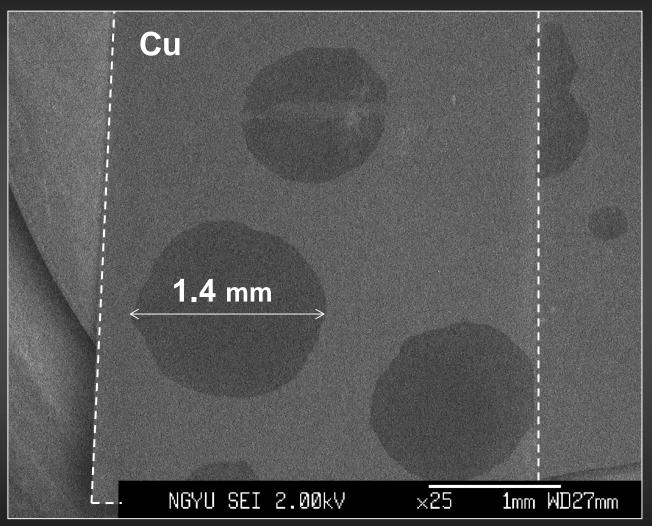
酸化処理Cu箔上に成長したグラフェンの 低倍率のSEM像

拡大像

Science, 342, 720-723 (2013)

Nature Comm., 3096 (2013)

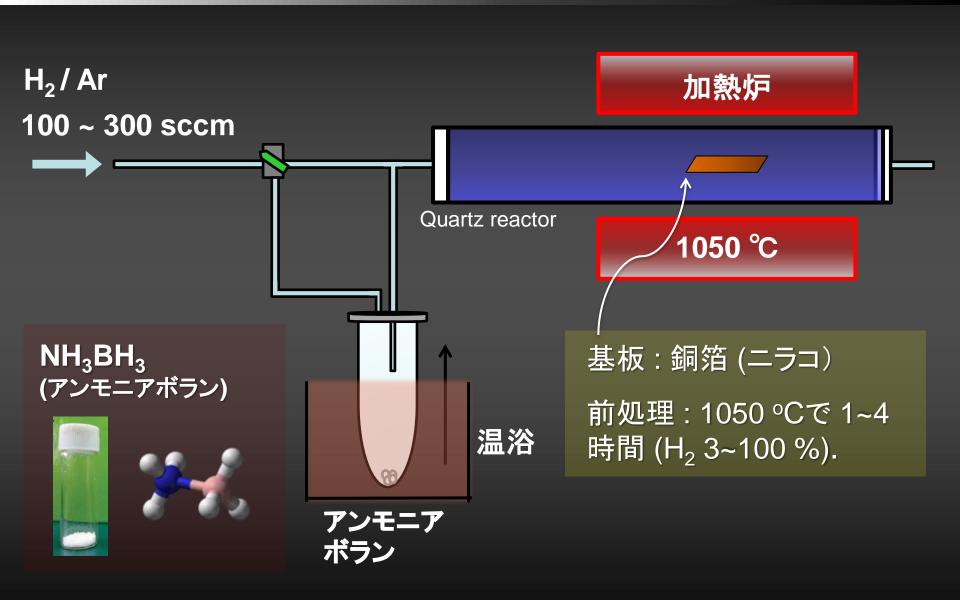
酸化処理の効果:巨大グラフェンの成長



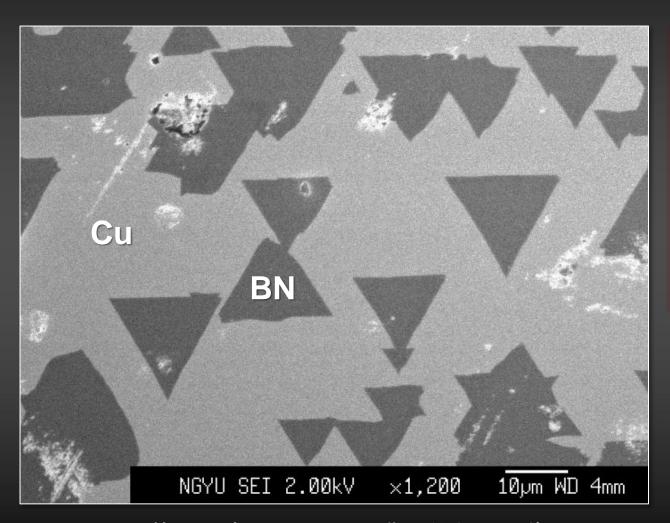
SEM image of giant graphenes

六方晶窒化ホウ素 hBN

hBNのCVD合成



hBNの構造評価:SEM観察



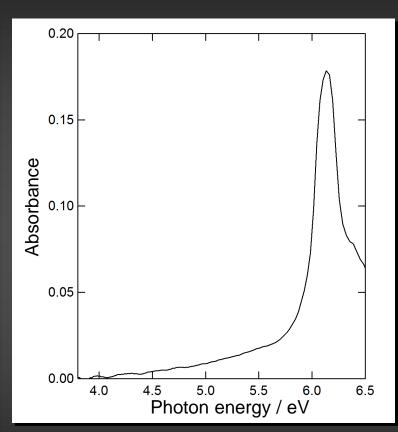


Cu箔上に成長したhBNの典型的なSEM像

hBNの構造評価:吸収分光



NGYU SEI 2.00kV ×600 10μm Cu箔上に成長したhBNのSEM像 250 x 150 μm



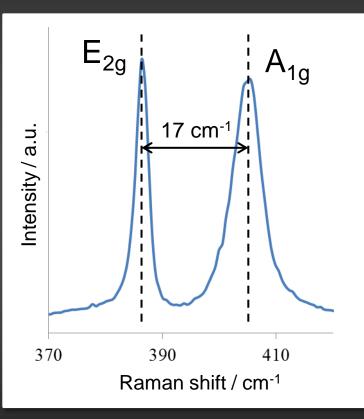
hBNの可視紫外吸収スペクトル

遷移金属ジカルコゲニド TMDC

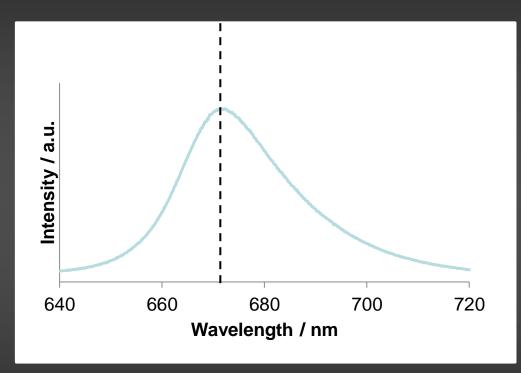
TMDCのCVD合成



TMDCsの構造評価:分光学的評価



Raman shift / cm $^{-1}$ MoS $_2$ の質MoS $_2$ のラマンスペクトル



MoS₂の蛍光スペクトル

